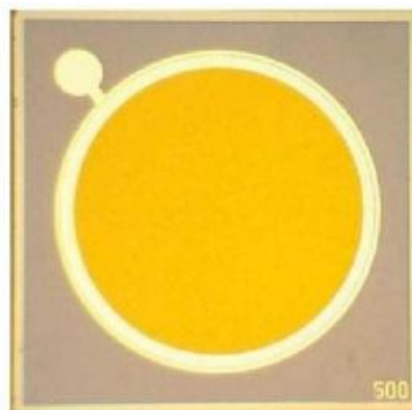


## 500um InGaAs APD Chip $\phi 500\mu\text{m}$



### 产品描述

InGaAs 雪崩光电二极管 (APD) 芯片

### 产品特点

$\phi 500\mu\text{m}$  有效面积; 高增益 $>30$  @ $V_{br}-1V$ ; 高响应度; 顶照式平面结构

### 应用领域

激光雷达 (LiDAR) | 测距仪 | 测量仪器

### 核心参数

无

无

## 详细参数

规格 (Tc=25°C, 单颗裸芯片)

| 参数       | 符号             | 最小值 | 典型值         | 最大值  | 单位   | 测试条件                       |
|----------|----------------|-----|-------------|------|------|----------------------------|
| 响应范围     | $\lambda$      | 900 |             | 1650 | nm   |                            |
| 击穿电压     | Vbr            | 40  |             | 55   | V    | I <sub>d</sub> =10uA       |
| VBR 温度系数 |                |     | 0.12        |      | V/°C |                            |
| 响应       | R              | 30  |             |      | A/W  | V <sub>R</sub> =Vbr-1V     |
| 暗电流      | I <sub>D</sub> |     | 60          | 200  | nA   | V <sub>R</sub> =Vbr-3V     |
| 电容       | C              |     | 8.0         |      | pF   | V <sub>R</sub> =38V;f=1MHz |
| 带宽       | Bw             |     | 1           |      | GHz  | 3dB down,RL=50Ω            |
| 有效区直径    | D              |     | 500         |      | um   |                            |
| 芯片尺寸     |                |     | 700*700*180 |      | um   | L*W*H                      |

\*可以为 LiDAR 定制任何芯片尺寸。